

圖 28 不同溫度所合成奈米 Gd(OH)₃ XRD 圖譜之比較: (a)140 , (b) 160 , (c) 180 , (d) 200 (Gd₂O₃ / Thiourea /pH=6)



圖 29 於 140 ,不同含釓反應物與硫脲反應所合成奈米 Gd(OH)₃ XRD 圖譜之比較:
(a)Gd₂O₃, (b)Gd(NO₃)₃ 6H₂O (pH<9), (c)Gd(NO₃)₃ 6H₂O (pH>10),
(d)GdCl₃ 6H₂O (pH<9) 與 (e)GdCl₃ 6H₂O (pH>10)



圖 30 以不同水熱溫度所合成奈米 Gd(OH)3 之 SEM 影像 (Gd2O3 / Thiourea / pH=6)



圖 31 以 Gd(NO₃)₃ 6H₂O(上二圖)或 GdCl₃ 6H₂O(下二圖)與硫脲反應所合成奈米 Gd(OH)₃之 SEM 影像



圖 32 前驅物 A 於 H₂S 氣氛中,不同退火溫度所合成奈米 Gd₂O₂S XRD 圖譜之比較: (a) 400,(b) 500,(c) 600,(d) 700,(e) 800,(f) 900 與 (g) 1000



圖 33 不同含釓反應物所得之前驅物,於600 H₂S 氣氛中所合成奈米 Gd₂O₂S XRD 圖譜
之比較:(a)前驅物 A,(b)前驅物 B,(c)前驅物 C,(d)前驅物 D 與 (e)前驅物 E



(B) 局部放大影像

圖 34 前驅物 A 於 600 H₂S 氣氛中反應所合成奈米 Gd₂O₂S 之 SEM 影像



(A) TEM 圖

(B) ED 圖

圖 35 前驅物 A 於 600 H_2S 氣氛中反應所合成奈米 Gd_2O_2S 之 TEM 影像與電子繞射環圖譜



圖 36 前驅物 A 於 H_2S 氣氛(不同溫度)中反應所合成奈米 Gd_2O_2S 之 SEM 影像之比較



(B) 局部放大影像

圖 37 前驅物 B 於 600 H_2S 氣氛中反應所合成奈米 Gd_2O_2S 之 SEM 影像



(B) 局部放大影像

圖 38 前驅物 C 於 600 H_2S 氣氛中反應所合成奈米 Gd_2O_2S 之 SEM 影像



(B) 局部放大影像

圖 39(a) 前驅物 C 於 600 H₂S 氣氛中反應所合成奈米 Gd₂O₂S 之 TEM 影像



圖 39(b) 前驅物 C 於 600 H_2S 氣氛中反應所合成奈米 Gd_2O_2S 之電子繞射環圖譜



圖 40 不同製程於 1000 熱處理所合成 Gd₂O₂S XRD 圖譜之比較:

(a)水熱法-前驅物 A, (b)固態(H₂S) 與 (c)固態(石墨)



(B) 局部放大影像

圖 41 固態法於 H_2S 氣氛中, 1000 所合成 Gd_2O_2S 之 SEM 影像



(B) 局部放大影像

圖 42 在石墨所提供還原氣氛於 1000 以固態法所合成 Gd_2O_2S 之 SEM 影像



圖 43 固態(H₂S)法合成之 Gd₂O₂S 主體自身活化光譜圖(a) $_{em} = 625 \text{ nm}$, (b) $_{ex} = 264 \text{ nm}$



圖 44 固態(H_2S)法合成之微米多晶 Gd_2O_2S 粉末全反射光譜: 實驗值(-△-) 與一次方線性回歸(——)



 圖 46 含不同 Tb 掺雜濃度之奈米(Gd_{2-x}Tb_x)O₂S 系列樣品放射 光譜:x=(a) 0.5%, (b) 1%, (c) 2%, (d) 3%與(e) 4% (前驅物 A:Tb 於 600 退火)



圖 47 含不同 Pr 摻雜濃度之奈米(Gd_{2-x}Pr_x)O₂S 系列樣品激發光譜: x = (a) 0.5%, (b) 1%, (c) 2%與(d) 3%, (前驅物 A:Pr 於 600 退火)



圖 48 含不同 Pr 掺雜濃度之奈米(Gd_{2-x}Pr_x)O₂S 系列樣品放射光譜: x = (a) 0.5%, (b) 1%, (c) 2%與(d) 3% (前驅物 A:Pr 於 600 退火)



圖 49 含不同 Eu 摻雜濃度之奈米(Gd_{2-x}Eu_x)O₂S 系列樣品激發光譜: x = (a) 0.5%, (b) 1%, (c) 2%與(d) 3%, (前驅物 A:Eu 於 600 退火)



圖 50 含不同 Eu 摻雜濃度之奈米 $(Gd_{2-x}Eu_x)O_2S$ 系列樣品放射光譜: x = (a) 0.5%, (b) 1%, (c) 2% 與(d) 3% (前驅物 A:Eu 於 600 退火)



圖 52 不同水熱法溫度 + 600 H₂S 退火所合成奈米(Gd_{1.97}Tb_{0.03})O₂S 放射光譜之比較: (a) 140 , (b)160 , (c)180 與 (d)200 (Gd₂O₃/Thiourea/pH=6)



圖 53 前驅物 A:Tb 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.97}Tb_{0.03})O₂S 激發 光譜之比較: (a) 600 , (b)700 , (c)800 , (d)900 與 (e)1000



圖 54 前驅物 A:Tb 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.97}Tb_{0.03})O₂S 放射 光譜之比較: (a) 600, (b)700, (c)800, (d)900 與 (e)1000



圖 55 前驅物 A:Pr 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.98}Pr_{0.02})O₂S 激發 光譜之比較: (a) 600 , (b)700 , (c)800 , (d)900 與 (e)1000



圖 56 前驅物 A:Pr 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.98}Pr_{0.02})O₂S 放射 光譜之比較: (a) 600 , (b)700 , (c)800 , (d)900 與 (e)1000



圖 57 前驅物 A:Eu 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.98}Eu_{0.02})O₂S 激發 光譜之比較: (a) 600 , (b) 700 , (c) 800 , (d) 900 與 (e) 1000



圖 58 前驅物 A:Eu 於不同退火溫度所合成之(Gd_{1.98}Eu_{0.02})O₂S 放射 光譜之比較: (a) 600, (b)700, (c)800, (d)900 與 (e)1000



圖 59 奈米(Gd_{2-x}R_x)O₂S 系列樣品之放射峰相對強度與摻雜離子濃度 關係圖(a)Tb³⁺, (b)Pr³⁺, (c)Eu³⁺ (前驅物 A:R 於 600 退火溫度)



圖 60 奈米($Gd_{2-x}R_x$) O_2S 系列樣品之放射峰相對強度與退火溫度關係圖(a) Tb^{3+} ,(b) Pr^{3+} ,(c) Eu^{3+} (前驅物 A:R 固定摻雜濃度於不同退火溫度)



圖 61 (Gd_{2-x}R_x)O₂S 螢光體 (a-c)R = Tb, 600、800、900 , (d-g)R = Pr, 600、700、800、1000 ,(h-k)R = Eu, 600、700、800、1000 之 CIE 色度座標之比較 (前驅物 A:R 固定摻雜濃度於不同退火溫度)



圖 62 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 激發光譜之比較: (a)前驅物 A:Tb, (b)前驅物 C:Tb, (c)前驅物 B:Tb, (d)前驅物 E:Tb 與(e)前驅物 D:Tb



圖 63 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 放射光譜之比較: (a)前驅物 A:Tb, (b)前驅物 C:Tb, (c)前驅物 B:Tb, (d)前驅物 E:Tb 與(e)前驅物 D:Tb



圖 64 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 激發光譜之比較: (a)前驅物 A:Pr, (b)前驅物 C:Pr



圖 65 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 放射光譜之比較: (a)前驅物 A:Pr, (b)前驅物 C:Pr 與 (c)前驅物 B:Pr



圖 66 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 激發光譜之比較: (a)前驅物 A:Eu, (b)前驅物 C:Eu



圖 67 不同釓來源所得之前驅物於 600 H₂S 退火溫度所合成奈米 (Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 放射光譜之比較: (a)前驅物 A:Eu, (b)前驅物 C:Eu 與 (c)前驅物 B:Eu



圖 68 以不同溶劑填充量所合成奈米(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 激發光譜 之比較:(a)60%與(b) 30% (前驅物 A:Tb 於 600 退火)



圖 69 以不同溶劑填充量所合成奈米(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 放射光譜 之比較:(a)30%與(b) 60% (前驅物 A:Tb 於 600 退火)



圖 71 以不同鹼液所合成奈米(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 激發光譜之比較 : (a)NaOH 與 (b) KOH (前驅物 A:Tb 於 600 退火)



圖 72 於 900℃ 或 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 激發光譜之比較: (a)水熱法-前驅物 A:Tb, (b)固態(H₂S) 與 (c)固態



圖 73 於 900℃ 或 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 放射光譜之比較:(a)水熱法-前驅物 A:Tb,(b)固態(H₂S)與(c)固態(石墨)



圖 74 於 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 激發光譜 之比較:(a)水熱法-前驅物 A:Pr,(b)固態(H₂S) 與 (c)固態(石墨)



圖 75 於 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 放射光譜 之比較:(a)水熱法-前驅物 A:Pr,(b)固態(H₂S) 與 (c)固態(石墨)



圖 76 於 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 激發光 譜之比較:(a)水熱法-前驅物 A:Eu,(b)固態(H₂S) 與 (c)固態(石墨)



圖 77 於 1000 熱處理,不同方法所合成(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 放射光 譜之比較:(a)水熱法-前驅物 A:Eu,(b)固態(H₂S) 與 (c)固態(石墨)



圖 78 以(a)水熱法-前驅物 A:Tb, (b)固態(H₂S)與(c)固態(石墨)等製程於 900 或 1000 熱處理所合成(Gd_{1.97}Tb_{0.03})O₂S 螢光體之 CIE 色度座標之比較



圖 79 以(a)水熱法-前驅物 A:Pr, (b)固態(H₂S)與(c)固態(石墨)等製程於 1000 熱處理所合成 (Gd_{1.98}Pr_{0.02})O₂S 螢光體之 CIE 色度座標之比較



圖 80 以(a)水熱法-前驅物 A:Eu, (b)固態(H₂S)與(c)固態(石墨)等製程於 1000 熱處理所合成 (Gd_{1.98}Eu_{0.02})O₂S 螢光體之 CIE 色度座標之比較